

電子情報通信学会 システムナノ技術に関する時限研究専門委員会主催

第3回研究会

「半導体技術でフォトン・フォノン・エレクトロンを制御する」

**開催主旨：**本研究会では、フォトン・フォノン・エレクトロンを制御するという長年の命題に対する半導体技術の挑戦を採り上げます。設計指針、作製および評価法、そして応用に至るまで、最新の研究開発動向について御講演いただきます。

**日時：**2018年1月19日（金）10:00~17:40

**会場：**理化学研究所 鈴木梅太郎記念ホール

〒351-0198 埼玉県和光市広沢 2-1 (<http://www.riken.jp/access/wako-map/>)

TEL: 048-462-1111 (代表)

**プログラム：**

9:30 受付開始

10:00~10:10 開会, 委員長挨拶

10:10~10:55 招待講演 「データ通信・産業用高機能半導体レーザ」  
株式会社 QD レーザ 武政 敬三

10:55~11:40 招待講演 「空間光変調器(SLM)を用いた高度光制御とその応用」  
浜松ホトニクス株式会社 中央研究所 豊田 晴義

11:40~12:25 招待講演 「AlGaN系紫外半導体レーザの現状とその可能性」  
名城大学 岩谷 素顕, 竹内 哲也, 上山 智, 赤崎 勇

12:25~14:00 昼食・展示会

14:00~14:45 招待講演 「ヘテロ接合をもちいたトンネル FET - 化合物半導体と二次元系半導体での  
アプローチ例 -」  
東京工業大学 宮本 恭幸, 金澤 徹

14:45~15:30 招待講演 「Ge系デバイスのヘテロロジーニアスインテグレーション技術」  
産業技術総合研究所 前田 辰郎

15:30~16:00 休憩・展示会

16:00~16:45 招待講演 「フォノンエンジニアリング(ナノスケール熱制御)の必要性和半導体技術者への期待」  
JST 馬場 寿夫

16:45~17:30 招待講演 「フォノンエンジニアリングによる低エネルギー分子センサの創製」  
慶應義塾大学 内田 建

17:30~17:40 閉会

18:00~ 交流会

**申込方法：**氏名, 連絡先(会社あるいは学校名, 所属, 郵便番号, 所在地, 電話番号), 交流会参加の有無を E-mailにて SNT 研究会事務局 ([hida@riken.jp](mailto:hida@riken.jp)) までお送り下さい。

**参加費：**一般 3,000 円、学生無料(資料が必要な場合は 1,000 円)、交流会 4,000 円

**申込締切：**2018年1月10日(水)

**問合せ：**JST 前野 仁典、e-mail: [y2maeno@jst.go.jp](mailto:y2maeno@jst.go.jp), 理化学研究所 飛田 聡、e-mail: [hida@riken.jp](mailto:hida@riken.jp)

(研究会 HP : <http://www.ieice.org/~snt/>)